

关键指标

频率: DC~40GHz

衰减值: 1dB, 2dB, 3dB, 4dB, 5dB

耐功率连续波: 1W, 2W

芯片尺寸: 0.66mm×0.81mm (HG108S-BX 系列)

0.7mm×0.72mm (HG108S-CX 系列)

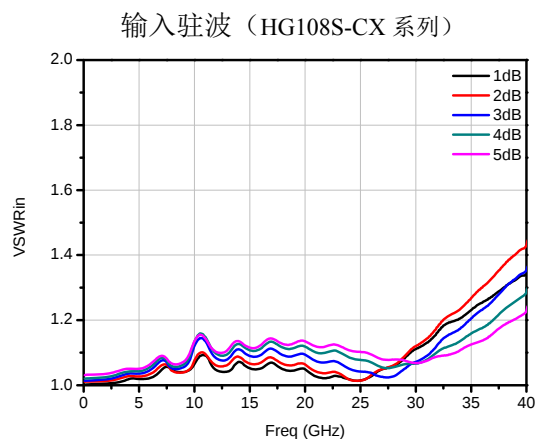
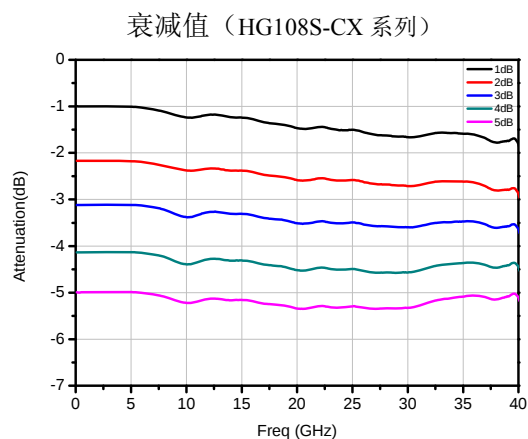
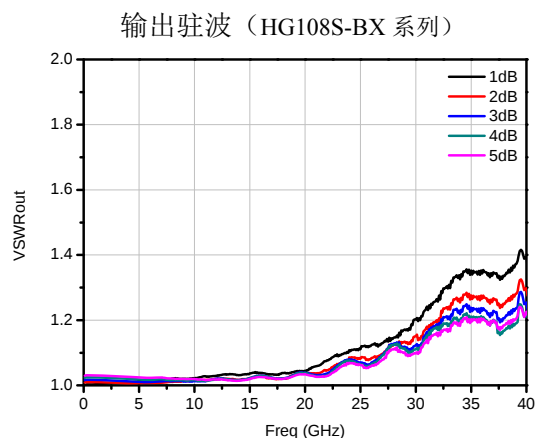
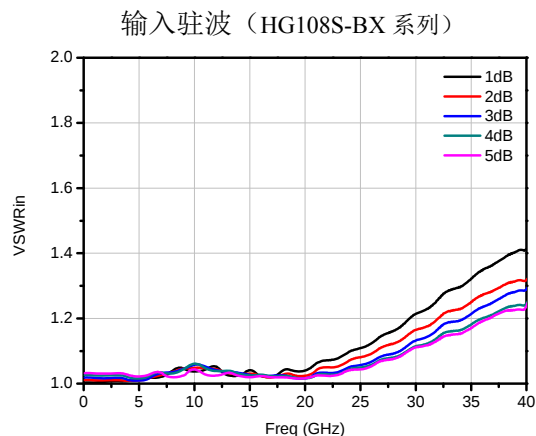
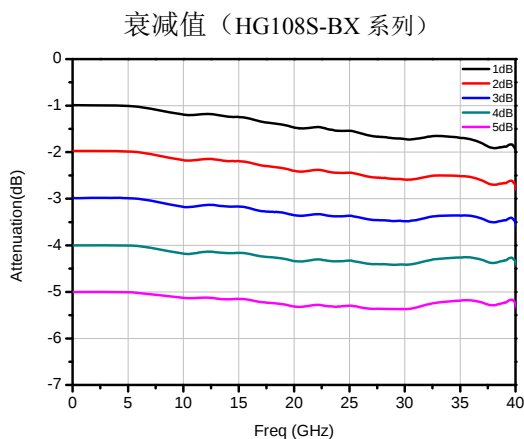
产品简介

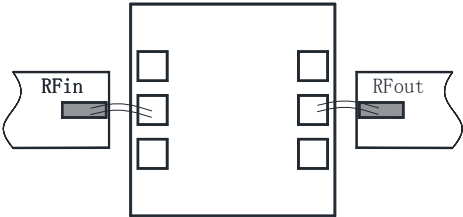
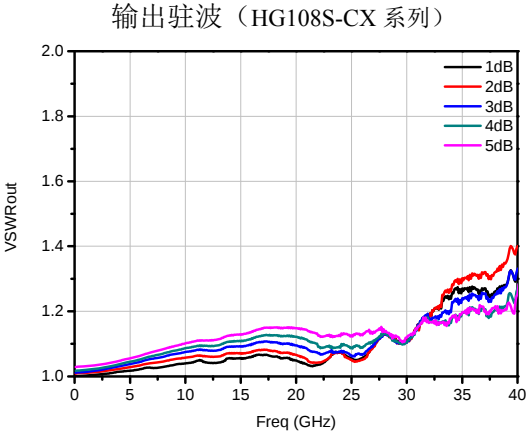
HG108S-XX 是一款工作在 DC~40GHz 的 1W/2W 固定衰减器芯片系列片。该芯片系列衰减器的衰减值为 1dB, 2dB, 3dB, 4dB, 5dB, 耐功率有 1W 和 2W 可供选择。

电性能 (T_A=25℃)

型号	耐功率	衰减量 (dB)	衰减平坦度(dB)	驻波 DC-20 GHz	驻波 20-40GHz
HG108S-B1	1W	1	0.5	1.02	1.3
HG108S-B2		2	0.5	1.02	1.3
HG108S-B3		3	0.4	1.02	1.3
HG108S-B4		4	0.3	1.02	1.3
HG108S-B5		5	0.3	1.02	1.3
HG108S-C1	2W	1	0.5	1.1	1.3
HG108S-C2		2	0.5	1.1	1.3
HG108S-C3		3	0.4	1.1	1.3
HG108S-C4		4	0.3	1.1	1.3
HG108S-C5		5	0.3	1.1	1.3

典型测试曲线





绝对最大额定值

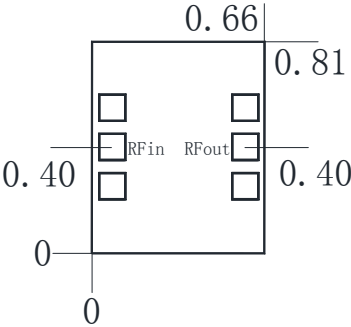
最大输入功率	+33dBm
工作温度	-55℃～125℃
贮存温度	-65℃～150℃

注意事项

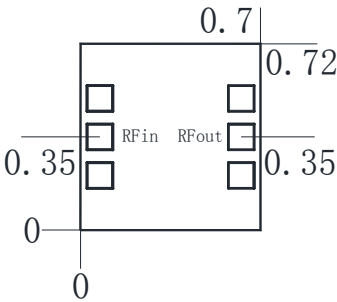
1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250～400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。

外形和端口尺寸（mm）

HG108S-BX 系列



HG108S-CX 系列



推荐装配图

